

日程表(会場別1)

会場名	収容人数	2021年3月16日(火)		2021年3月17日(水)		2021年3月18日(木)		2021年3月19日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
Z01	1000	10:00 ~ 11:45 T22 インフォーマティクスとロボティクスの融合による材料開発の革新	13:00 ~ 16:20 T22 インフォーマティクスとロボティクスの融合による材料開発の革新		13:00 ~ 18:00 SP1 一般公開]新型コロナウイルス禍に学ぶ応用物理：未来社会に向けて	09:50 ~ 12:10 NT1 一般公開]就活生必見！Withコロナ時代に加速するDXに欠かせない半導体	13:30 ~ 18:00 NT2 一般公開]時代の変革期に、応用物理分野を輝かせよう	09:00 ~ 12:00 1.2 教育	13:30 ~ 16:50 T1 一般公開]新型コロナウイルス禍中の物理教育・人材育成
Z02	500	10:00 ~ 11:40 T13 多元系化合物が牽引する太陽光利用拡大と応用物理	13:30 ~ 17:00 T13 多元系化合物が牽引する太陽光利用拡大と応用物理	09:00 ~ 12:30 T18 モジュール科学の立ち上げに向けて 各種半導体デバイス/パッケージ技術の相互検証	13:30 ~ 16:45 T19 相変化メモリ材料の進展と将来展望	09:00 ~ 11:50 T20 ニューノーマル時代のDXを進めるIoT用創エネルギ-材料・デバイス研究の新展開	13:00 ~ 16:30 T20 ニューノーマル時代のDXを進めるIoT用創エネルギ-材料・デバイス研究の新展開	10:00 ~ 12:00 1.5 計測技術・計測標準	13:30 ~ 16:15 CS.7.8.3 プラズマナノテクノロジー・9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート・13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション
Z03	500	09:30 ~ 12:05 T9 協奏的量子ビーム利用による実用材料研究のススメー新しいビームはいかがですかー	13:30 ~ 17:25 T9 協奏的量子ビーム利用による実用材料研究のススメー新しいビームはいかがですかー	09:00 ~ 11:45 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 17:40 T11 プラズマエレクトロニクス分科会 30周年記念シンポジウム：ニューノーマル時代の確立に資するプラズマエレクトロニクス		14:30 ~ 18:35 T10 EUV・軟X線イメージングの描く未来	09:15 ~ 11:45 3.10 光量子物理・技術	13:30 ~ 17:00 3.10 光量子物理・技術
Z04	500	09:30 ~ 12:00 T14 晶層の工学：多形・組織制御で拓く協創結晶科学	13:00 ~ 15:45 T14 晶層の工学：多形・組織制御で拓く協創結晶科学	09:00 ~ 12:00 1.1 応用物理一般・学際領域	13:30 ~ 18:10 T16 一般公開]先進モビリティ/ワークエレクトロニクス技術の進化	09:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセス	13:30 ~ 18:30 T17 特異構造の結晶科学 ～学術とエレクトロニクス展開～	09:00 ~ 12:05 3.4 生体・医用光学	14:00 ~ 17:15 3.4 生体・医用光学
Z05	500	9:30 ~ 12:00 TU1 デラヘルツ半導体技術の最新動向とイメージング応用	13:30 ~ 18:00 T6 量子マテリアルとTHz-赤外光電場が拓くフォトニクス応用	09:00 ~ 12:00 CS.3.3.11 フォトニック構造・現象 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション	13:30 ~ 17:15 T4 レーザー-誘起ナノ周期構造の本質と展望に迫る	09:00 ~ 12:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30 ~ 18:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	09:00 ~ 11:45 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	13:30 ~ 17:15 3.14 光制御デバイス・光ファイバー
Z06	500	9:30 ~ 11:30 TU2 ドラゴエクスによる薄膜作製のための真空技術ー基礎から応用までー	13:30 ~ 17:20 T3 量子コンピュータの現状と展望	09:45 ~ 12:00 6.5 表面物理・真空	13:30 ~ 16:00 TU3 応用物理における群論の基礎	09:00 ~ 11:45 3.6 超高速・高強度レーザー	13:00 ~ 17:25 T23 一般公開]AI/IoT時代を支えるポストムーアパラダイムへの挑戦	09:00 ~ 11:15 3.6 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 16:30 3.6 超高速・高強度レーザー
Z07	500	9:00 ~ 12:10 TU6 スピンエレクトロニクス入門	13:30 ~ 17:30 T15 パワーデバイスの最新動向と今後の展望	09:15 ~ 11:45 3.10 光量子物理・技術	13:00 ~ 18:00 TU4 機能性酸化物エレクトロニクスーはじめての歩ー		13:30 ~ 17:25 T12 スピンを利用した量子技術の最新動向 - 量子デバイス開発から新材料探索まで -	09:00 ~ 12:00 3.7 レーザープロセス	13:30 ~ 16:00 3.7 レーザープロセス
Z08	500	09:00 ~ 12:00 3.8 光計測技術・機器	13:30 ~ 18:15 3.8 光計測技術・機器	09:00 ~ 12:00 3.8 光計測技術・機器	13:30 ~ 17:35 T5 フォトニクスとコンピューティングの先駆動向	09:00 ~ 12:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:00 ~ 18:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	09:00 ~ 12:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:15 ~ 17:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学
Z09	500	10:00 ~ 11:45 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域	09:00 ~ 10:45 3.9 デラヘルツ全般	13:30 ~ 18:00 T7 革新的走査型プローブ顕微鏡技術で拓くナノプロセッシングの最新展開	09:00 ~ 10:45 3.9 デラヘルツ全般	13:30 ~ 17:15 3.9 デラヘルツ全般	09:00 ~ 11:45 3.2 材料・機器光学	
Z10	500	09:15 ~ 12:00 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	13:30 ~ 18:15 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	09:15 ~ 12:00 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	14:00 ~ 17:35 T8 固体量子センサの現状と将来展望	09:15 ~ 12:00 CS.4.3.11 フォトニック構造・現象 3.13 半導体光デバイスのコードシェアセッション	14:00 ~ 16:50 3.11 フォトニック構造・現象	09:15 ~ 12:00 3.11 フォトニック構造・現象	13:15 ~ 17:30 3.11 フォトニック構造・現象
Z11	500		13:30 ~ 17:15 3.5 レーザー装置・材料	09:00 ~ 12:00 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	13:30 ~ 16:45 T2 イオンビーム分析の最新動向と展望	09:00 ~ 12:30 2.1 放射線物理一般・検出器基礎		09:00 ~ 12:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:15 ~ 17:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学
Z12	500	9:00 ~ 12:00 TU5 半導体製造プロセスにおけるAI技術適用と機械学習の基礎	13:00 ~ 19:45 8.8 プラズマエレクトロニクス分科会 30周年記念特別セッション		13:30 ~ 18:30 T21 グラフン研究の進展と今後の展望ーノーベル物理学賞受賞から10年ー	09:00 ~ 12:00 2.5 医用応用	13:30 ~ 14:45 2.5 医用応用	09:00 ~ 12:00 2.6 放射線誘起蛍光体	13:30 ~ 17:45 2.6 放射線誘起蛍光体
Z13	300	09:00 ~ 12:15 13.3 絶縁膜技術	13:30 ~ 16:45 1.1 応用物理一般・学際領域	09:00 ~ 11:30 1.6 超音波	13:30 ~ 15:45 1.6 超音波	09:30 ~ 12:30 6.2 カーボン系薄膜	14:00 ~ 17:30 6.2 カーボン系薄膜	10:00 ~ 12:00 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 17:15 6.1 強誘電体薄膜
Z14	300		13:30 ~ 14:45 CS.6.6.5 表面物理・真空・7.6 原子・分子線およびビーム関連技術のコードシェアセッション	13:00 ~ 15:30 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:00 ~ 15:30 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	09:00 ~ 12:15 7.1 X線技術	13:15 ~ 14:15 7.1 X線技術	09:00 ~ 12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 18:15 6.3 酸化物エレクトロニクス
Z15	300	10:00 ~ 11:45 6.6 フロー顕微鏡	13:30 ~ 17:15 6.6 フロー顕微鏡	10:00 ~ 11:45 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 18:45 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	09:15 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:30 ~ 17:30 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 16:15 6.4 薄膜新材料
Z16	300	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:30 ~ 17:30 1.3 新技術・複合新領域		13:30 ~ 15:30 7.2 電子ビーム応用	09:00 ~ 11:15 7.3 微細/ナノ・微細構造形成技術	13:30 ~ 18:00 9.1 誘電材料・誘電体	10:00 ~ 11:45 9.3 ナノエレクトロニクス	13:30 ~ 15:00 9.3 ナノエレクトロニクス
Z17	300	09:30 ~ 11:45 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 17:15 12.1 作製・構造制御	09:00 ~ 12:00 9.4 熱電変換	13:30 ~ 18:45 9.4 熱電変換	09:00 ~ 12:00 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 19:00 8.1 プラズマ生成・診断	10:00 ~ 12:00 8.3 プラズマナノテクノロジー	13:30 ~ 18:15 8.4 プラズママイクロデバイス
Z18	300	10:00 ~ 12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 16:45 12.4 有機EL・トランジスタ	09:15 ~ 12:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:00 ~ 17:15 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	09:00 ~ 12:00 3.16 Optics and Photonics English Session	18:00 ~ 18:45 8.6 Plasma Electronics English Session	09:00 ~ 12:15 12.4 有機EL・トランジスタ	13:45 ~ 17:30 12.4 有機EL・トランジスタ
Z19	300	09:00 ~ 12:00 10.5 磁場応用	13:00 ~ 19:30 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	09:00 ~ 12:15 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:15 ~ 15:00 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術			09:00 ~ 12:15 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	13:30 ~ 15:15 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関
Z20	300	09:00 ~ 12:00 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 16:30 12.5 有機太陽電池	09:30 ~ 11:30 11.1 基礎物性	13:30 ~ 17:00 11.1 基礎物性	10:00 ~ 12:00 6.1 強誘電体薄膜	13:30 ~ 16:45 12.5 有機太陽電池		
Z21	300	09:00 ~ 11:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:00 ~ 10:30 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	13:30 ~ 16:15 11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	10:30 ~ 11:30 CS.2.3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション	13:30 ~ 17:30 12.6 ナノバイオテクノロジー		
Z22	300	09:00 ~ 11:45 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 17:45 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 11:45 11.4 アナログ応用および関連技術	13:30 ~ 16:00 11.4 アナログ応用および関連技術	09:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 17:45 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 12:00 3.13 半導体光デバイス	13:30 ~ 18:00 3.13 半導体光デバイス
Z23	300	09:00 ~ 12:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 16:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	09:00 ~ 12:00 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 18:15 12.2 評価・基礎物性	09:00 ~ 12:00 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	13:30 ~ 18:00 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	09:30 ~ 11:30 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	
Z24	300	09:00 ~ 10:00 15.2 III-V族結晶および多元系結晶	13:30 ~ 18:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:30 ~ 11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 17:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 11:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:30 ~ 17:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 11:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 16:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術
Z25	300		13:30 ~ 16:15 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション					09:30 ~ 11:45 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:00 ~ 16:45 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術
Z26	300	09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 17:30 CS.5.6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア	09:00 ~ 11:15 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 18:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術			09:00 ~ 10:45 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 16:00 13.8 光物性・発光デバイス
Z27	500	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:15 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 17:15 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	09:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:00 15.4 III-V族窒化物結晶
Z28	300	09:00 ~ 12:00 2.2 検出器開発	13:30 ~ 19:15 2.2 検出器開発	09:00 ~ 11:45 15.5 IV族系化合物 (SiC)	13:30 ~ 18:00 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎			09:15 ~ 12:00 3.3 情報フォトニクス・画像工学	13:30 ~ 18:00 3.3 情報フォトニクス・画像工学
Z29	300	10:00 ~ 10:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 17:00 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	09:30 ~ 12:15 22.1 合同セッションM「フロンティア」	13:30 ~ 16:15 16.3 シリコン系太陽電池	10:00 ~ 12:15 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 16:00 16.3 シリコン系太陽電池	09:00 ~ 11:30 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	13:00 ~ 16:45 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥
Z30	300	09:00 ~ 12:00 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:30 ~ 17:15 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料						

日程表(会場別2)

会場名	収容人数	2021年3月16日(火)		2021年3月17日(水)		2021年3月18日(木)		2021年3月19日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
Z31	300	09:00 ~ 12:00 17.2 グラフエン	13:30 ~ 18:30 17.2 グラフエン	09:00 ~ 11:45 17.2 グラフエン	13:15 ~ 17:30 3.11 フォトニック構造・現象	09:30 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 18:30 17.3 層状物質	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	
Z32	300	09:30 ~ 12:15 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:30 ~ 18:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	09:30 ~ 11:30 15.1 パルク結晶成長	13:30 ~ 16:30 15.1 パルク結晶成長	09:00 ~ 11:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:30 ~ 16:30 3.7 レーザープロセス	09:00 ~ 11:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:30 ~ 17:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」
Z33	300	09:00 ~ 12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 17:15 6.3 酸化物エレクトロニクス	10:00 ~ 12:00 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	13:30 ~ 15:30 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	09:00 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 18:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 12:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:30 ~ 18:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
Z34	300	09:00 ~ 12:00 CS.1 2.4 加速器質量分析・加速器ビーム分析・7.5 イオンビーム一般のコードシェアセッション	13:15 ~ 17:30 CS.1 2.4 加速器質量分析・加速器ビーム分析・7.5 イオンビーム一般のコードシェアセッション					09:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 18:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」
Z35	300	09:15 ~ 12:00 9.5 新機能材料・新物性	13:30 ~ 15:45 9.5 新機能材料・新物性	09:00 ~ 11:45 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 16:45 13.9 化合物太陽電池				
Z36	300		17:00 ~ 18:00 第21回応用物理学会業績賞 授賞式、研究分野業績賞 授賞式、APEX/JJAP編集員賞 授賞式、第49回応用物理学会講演奨励賞 授賞式						
P	300	[09:00-09:50] 12.2 評価・基礎物性 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	[13:00-13:50] 15.4 III-V族窒化物結晶 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	[09:00-09:50] 3.1 光学基礎・光学新領域 3.5 レーザー装置・材料 3.6 超高速・高強度レーザー 3.7 レーザープロセス	[13:00-13:50] 3.9 テラヘルツ全般 3.13 半導体光デバイス 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	[09:00-09:50] 3.8 光計測技術・機器 3.10 量子物理解・技術	[13:00-13:50] 3.2 材料・機器光学 3.4 生体・医用光学 3.11 フォトニック構造・現象	[09:00-09:50] 7.ビーム応用 8 プラズマエレクトロニクス	[13:00-13:50] 17 ナノカーボン
		[10:00-10:50] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 1.6 超音波	[14:00-14:50] 11 超伝導	[10:00-10:50] 6.3 酸化物エレクトロニクス 12.6 ナノバイオテクノロジー	[14:00-14:50] 1.5 計測技術・計測標準	[10:00-10:50] 10 スピントロニクス・マグネティクス	[14:00-14:50] 12.4 有機EL・トランジスタ	[10:00-10:50] 1.2 教育 8 プラズマエレクトロニクス	[14:00-14:50] 17 ナノカーボン
		[11:00-11:50] 3.3 情報フォトニクス・画像工学 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	[15:00-15:50] 6.2 カーボン系薄膜 6.5 表面物理・真空	[11:00-11:50] 6.4 薄膜新材料 6.6 プローブ顕微鏡 12.7 医用工学・バイオチップ	[15:00-15:50] 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	[11:00-11:50] 10 スピントロニクス・マグネティクス	[15:00-15:50] 2 放射線	[11:00-11:50] 13.8 光物性・発光デバイス	[15:00-15:50] 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎
			[16:00-16:50] 9.1 誘電材料・誘電体 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 9.3 ナノエレクトロニクス		[16:00-16:50] 12.1 作製・構造制御 12.5 有機太陽電池		[16:00-16:50] 2 放射線		[16:00-16:50] 9.4 熱電変換
			[17:00-17:50] 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.3 絶縁膜技術 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術		[17:00-17:50] 13.9 化合物太陽電池		[17:00-17:50] 2 放射線 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス 16.3 シリコン系太陽電池		[17:00-17:50] 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 13.7 化合物及びバワー電子デバイス・プロセス技術